산업통상자원부	보도참고자료	다시, 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 배포즉시 배포 2023. 3. 31.(금)

일본, 대(對)세계 반도체 장비 수출통제 강화 발표, 우리 기업 영향 크지 않을 것으로 전망

- 한일 정상회담 계기 조성된 양국 수출통제 당국 간 협의환경을 바탕으로, 우리 기업에 미치는 영향이 최소화되도록 긴밀한 협의 추진 -

일본 정부는 3.31.(금) 23개 첨단 반도체 제조 장비를 對세계 수출통제 대상에 추가한다는 방침을 발표하고 경산성 홈페이지에 동 내용 관련 성령(省令) 개정안을 게시하여 의견수렴 절차에 착수하였다.

일본의 금번 조치는 세계적으로 첨단 반도체 장비의 군용 전용 이슈가 제기됨에 따라, 기존 수출통제 대상이 아니었던 일부 품목을 허가대상에 추가한 것으로, 전 세계를 대상으로 적용되는 조치이다.

우리 기업들은 기존에도 일본의 수출통제 절차에 따라 장비를 차질없이 도입해 왔으며, 금번 추가된 품목들도 군용 전용 방지가 목적인 바, 우리 기업에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 예상된다.

정부는 금번 한일 정상회담을 계기로 조성된 양국 수출통제 당국간 협의 환경을 기반으로 수출관리 정책대화 등을 통해 우리 기업에 미치는 영향이 최소화되도록 일본과 긴밀히 협의해 나갈 것이다.

아울러 일본의 반도체 장비 수출통제 조치의 세부 품목을 면밀히 분석하여, 우리 소부장 경쟁력 강화 정책도 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

【참 고】 일본 반도체 장비 수출통제 조치 주요 내용

담당 부서	무역안보정책관 무역안보정책과	책임자	과 장	김영만 (044-203-4830)
		담당자	서기관	서성민 (044-203-4831)
			사무관	김미연 (044-203-4059)
	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	서기관	차세운 (044-203-4271)

참고 **일본 반도체 장비 수출통제 조치 내용**

1. 조치 개요

□ **(조치 배경)** 반도체 장비 관련국의 수출통제 동향을 반영하고 반도체 장비의 **군사전용 방지 목적**으로 **첨단 반도체 제조장비**에 대한 **수출통제** 실시

□ **(적용 대상)** 특정국가 대상이 아닌 전세계가 대상

□ **(시행 일정)** 경산성 성령(수출무역관리령 별표 제1 및 외환령 별표) **개정안 발표**(3.31) → **의견수렴** → **공포일로부터 2개월 후 시행**

2. 통제대상 품목 : 첨단 반도체 제조장비(총 23종)

연번	품목
1	펠리클 제조 장치
2	웨이퍼 처리를 위한 스텝앤드리피트 또는 스텝앤드스캔 방식의 노광장치(광학방식인 것)
3	EUV를 이용한 집적회로 제조장치용으로 조합한 레지스트 도포·성막·가열·현상 장치
4	건식 식각 장치(등방성 또는 이방성 건식 식각용으로 설계 또는 개조된 것)
5	습식 식각 장치(실리콘게르마늄의 실리콘에 대한 식각 선택성 비율이 100배 이상인 것)
6	이방성 식각 장치(유전체 재료에서 식각 폭(100nm 미만) 대비 깊이 비율이 30배를 넘는 것)
7	반도체 제조장치 중 성막장치(전기도금에 의해 코발트를 성막하는 것 등)
8	진공상태에서 또는 불활성가스 환경에서의 금속층 성막 장치
9	진공상태 또는 불활성가스 환경에서의 금속층 성막 장치(배리어막을 이용하지 않고 텅스텐 또는 몰리브덴을 성장시키는 것)
10	유기금속화합물을 이용하는 루테늄층 성막 장치(웨이퍼기판 온도 20도~500도 유지)
11	공간적 원자층 퇴적 장치(플라즈마에 의해 원자층을 성막하는 것 등)
12	400도~650도에서의 성막 장치 또는 웨이퍼와 별개 공간에서 발생한 라디칼에 의한 화학반응 촉진에 따른 성막 장치
13	EUV 마스크용 다층 반사막 성막 장치(이온빔 증착 또는 물리적 기상 성장법에 의해 성막)
14	실리콘 또는 실리콘게르마늄 에피택셜 성장 장치
15	플라즈마에 의한 카본하드마스크 성막 장치
16	텅스텐막 성막 장치(플라즈마를 이용한 원자층 퇴적법 또는 화학적 기상 성장법에 의해 성막)
17	금속배선 사이의 틈에 저유전(低誘電)층을 빈틈없이 플라즈마에 의해 성막하는 장치
18	진공상태에서 가동하는 아닐 장치
19	진공상태에서 고분자 찌꺼기 및 구리 산화막을 제거하는 구리 성막 장치
20	드라이 프로세스에 의한 표면의 산화물 또는 오염물 제거 장치(복수의 챔버 또는 스테이션을 가진 것)
21	매엽(枚葉)식 습식 세정 장치(웨이퍼 표면 개질(改質) 이후에 건조 공정이 있는 것)
22	EUV를 이용한 집적회로 제조장치용 마스크 검사 장치
23	펠리클로서, EUV를 이용하여 집적회로를 제조하기 위한 장치용으로 설계된 것